

©1995 г.

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ЦАРЕНКОВ

(к 65-летию со дня рождения)

19 июня 1995 года исполнилось 65 лет члену редколлегии нашего журнала, заведующему Лабораторией физических проблем полупроводниковой электроники Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе РАН профессору Б.В.Царенкову.

Борис Васильевич Царенков — известный российский физик, специалист в области физики полупроводников и полупроводниковой электроники.

Вся его жизнь в науке связана с Физтехом, куда он пришел в 1954 году после окончания Ленинградского электротехнического института им. В.И.Ульянова (Ленина) в лабораторию Д.Н.Наследова. Это было время становления полупроводников $A^{III}B^V$, и Б.В.Царенков стал основоположником создания и исследования $p-n$ -структур на основе $A^{III}B^V$ в СССР: он создал первую в стране GaAs- $p-n$ -структуру (1956), на этой основе изготовил солнечный фотоэлектропреобразователь (1957) и впоследствии создал первый светодиод (1962).

Главный фундаментальный результат этих лет — открытие им совместно с Д.Н.Наследовым, А.А.Рогачевым и С.М.Рывкиным высокоэффективной излучательной рекомбинации и стимулированного излучения в полупроводнике (1962), что привело к созданию полупроводникового лазера и люминесцентной электроники полупроводников $A^{III}B^V$.



Б.В.Царенков разработал диффузионную технологию $p-n$ -структур на основе GaAs и GaP; ему принадлежит первое отечественное изобретение по жидкофазной эпитаксии полупроводников $A^{III}B^V$ (1965), что положило начало разработке этой технологии в стране.

Под его научным руководством в 60-е годы на заводе «Старт» было создано первое в стране промышленное производство светодиодов и первое опытное производство полупроводниковых лазеров.

В последующие годы Б.В. Царенков с сотрудниками выполнил фундаментальные исследования электронных и оптоэлектронных явлений в $p-n$ - и $m-s$ -структурах на основе арсенида и фосфида галлия, в варизонных структурах $A^{III}B^V$.

В настоящее время он сосредоточен на проблемах коротковолновой фотоэлектроники и контакта металл-полупроводник.

Б.В. Царенков постоянно заботится о росте профессионализма своих учеников: 35 из них стали кандидатами и 8 — докторами наук.

Последние 20 лет он обучает физическим основам полупроводниковой электроники студентов базовой Кафедры оптоэлектроники ЛЭТИ при ФТИ.

Б.В. Царенков — лауреат Ленинской премии (1964) за участие в фундаментальных исследованиях, приведших к созданию полупроводниковых лазеров. Отмечен золотой, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР.

Мы желаем Борису Васильевичу здоровья, оптимизма и успехов в науке.

Редакционная коллегия ФТП
